

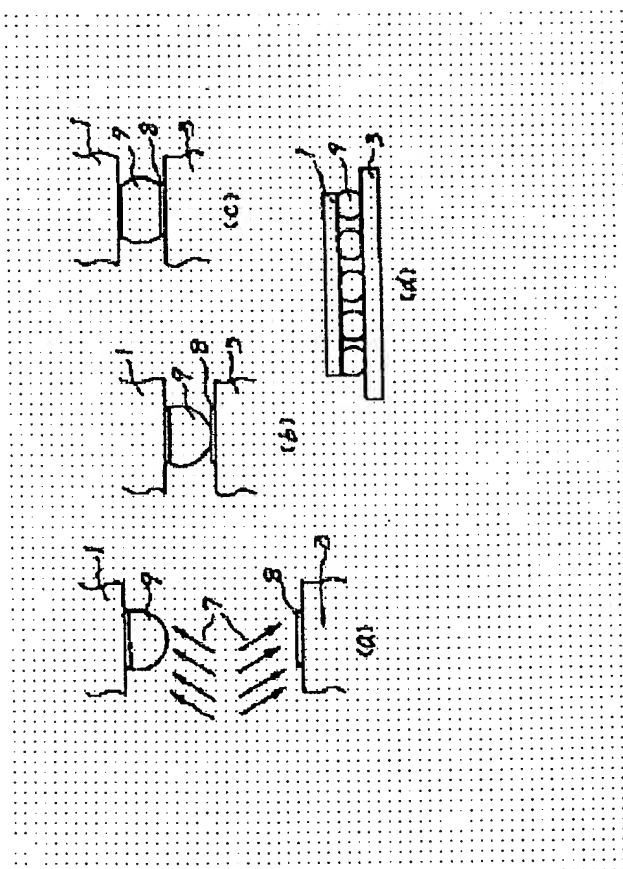
MANUFACTURE OF ELECTRONIC CIRCUIT DEVICE

Patent number: JP3241755
Publication date: 1991-10-28
Inventor: NISHIKAWA TORU; others: 04
Applicant: HITACHI LTD
Classification:
- International: H01L21/60; B23K1/00; B23K1/20; B23K31/02; B23K35/26; B23K35/30
- european:
Application number: JP19900036033 19900219
Priority number(s):

Abstract of JP3241755

PURPOSE: To contrive to improve workability by conducting a work such as aligning a member and brazing filler metal in the air and by non-flux bonding them.

CONSTITUTION: A semiconductor integrated circuit 1 is bonded by the use of Pb5Sn solder 9 to a metallization pad 8 formed by baking tungsten and molybdenum in the making process of a ceramic substrate 3 and then by successively plating the substrate with Ni, Au. That is, both Pb5Sn solder 9 and metallization pad 8 are subjected to sputter cleaning by Ar atom 7 for the purpose of removing an oxidation zone and organic pollution layer. Then, after an alignment in the air shown in Figure 4(b), heat fusion is conducted in H₂/N₂ (H₂:N₂=1:3) furnace and bonding is made to obtain a non-flux and satisfactory bonded part. Thus, it is possible to contrive to make an apparatus pollution-free and to improve its reliability by an easy work and simple equipment.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

Partial translation of JP-A-3-241755

Claim 1:

1. A method for manufacturing an electronic circuit device by bonding two different materials or parts with a brazing filler characterized in that, after polluted layer and oxidized layer on surfaces of the parts to be bonded and the brazing filler are removed by atomic or ionic sputter cleaning, they are aligned in atmosphere, and they are bonded to each other at a non-flux condition by heat-melting the brazing filler in a non-oxidizing atmosphere.

Claim 2:

2. The manufacturing method according to claim 1, wherein the brazing filler comprises Pb and Sn, Sn and Ag, Au and Sn, Au and Ge, Au and Si, or a combination thereof, and an exposure time in an atmosphere after the sputter cleaning is within 6 hours.

Page 3, left upper column, lines 15-19:

After the alignment was carried out within 30 minutes in an atmosphere as shown in Fig. 4(b), it was heat-melted in a furnace of H_2/N_2 ($H_2:N_2=1:3$) and a bonding was carried out, and a good bonding portion could be obtained at a non-flux condition as shown in Fig. 4(c).

⑫ 公開特許公報(A) 平3-241755

⑮ Int. Cl.⁸H 01 L 21/60
B 23 K 1/00
1/20

識別記号

3 1 1 S
3 3 0 E
H

庁内整理番号

6918-5F
7217-4E
7217-4E※

⑬ 公開 平成3年(1991)10月28日

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全6頁)

⑭ 発明の名称 電子回路装置の製造方法

⑯ 特 願 平2-36033

⑰ 出 願 平2(1990)2月19日

⑱ 発 明 者 西 川 徹 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技術研究所内

⑱ 発 明 者 佐 藤 了 平 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技術研究所内

⑱ 発 明 者 原 田 正 英 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技術研究所内

⑱ 発 明 者 林 田 哲 哉 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス開発センタ内

⑲ 出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑳ 代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

明 細 書

1 発明の名称

電子回路装置の製造方法

2 特許請求の範囲

1. 2つの異なる材料あるいは部材をろう材で接合する電子回路装置の製造方法において、被接合材およびろう材の表面の汚染層、酸化層を、原子あるいはイオンでスパッタクリーニング除去後、大気中で位置合わせ作業し、非酸化性雰囲気中でろう材を加熱溶融することにより、ノンフラックスで接合したことを特徴とする電子回路装置の製造方法。
2. ろう材がPbとSn、SnとAg、AuとSn、AuとGe、AuとSi、およびこれらの組合せからなり、スパッタクリーニング後の大気中暴露時間が8時間以内であることを特徴とする請求項1記載の製造方法。
3. 雰囲気、フッ素系ガスであることを特徴とする請求項1記載の製造方法。
4. 雰囲気が、N₂、Ar、He等の不活性雰囲気

であるとする請求項1記載の製造方法。

5. 雰囲気が、H₂/N₂、H₂等の活性雰囲気であることを特徴とする請求項1記載の製造方法。

3 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、2つの異なる材料あるいは部材をろう付した電子回路装置の製造方法において、ノンフラックスで接合した電子回路装置の製造方法に関する。

(従来の技術)

従来、イオンビームを用いたノンフラックス接合方法については、ジェイ・バキューム・サイエンス・テクノロジー、20(3)、3月号、1982年、第359頁から第363頁(J. Vac. Sci. Technol., 20(3), March, 1982, pp359-363)において論じられている。

また、通常、ろう材を用いて2つの異なる材料あるいは部材を接合する場合、フラックスが用いられている。フラックスを用いることにより、材料あるいは部材およびろう材の表面の酸化皮膜を

除去し、再酸化を防止して表面の清浄さを保ち、ろう材の材料あるいは部材へのぬれを促進させることができる。しかし、従来、フラックスを用いて接合を行った場合、第1図に示すように、フラックスの気化によるボイドが発生し接合強度が低下するという問題があった。

ノンフラックスを用いて部材を接合する場合、スパッタクリーニング後ろう材表面に酸化皮膜が成長するのを防止するために、部材等の位置合わせを非酸化雰囲気中で行っていた。

〔発明が解決しようとする課題〕

上記従来技術は、以下の点について配慮されておらず、信頼性の高い接合部形成ができない事、およびフラックスの洗浄作業による環境汚染（オゾン層の破壊）という問題があった。

- (1) 接合中に、フラックスの気化によるボイドが発生し、接合信頼性を低下させる。
- (2) フラックスを、フロンおよび塩素系有機溶剤で洗浄する工程が必要である。また、フラックス残渣を完全に洗浄することが難しい。

・ 3 ・

ため、スパッタクリーニングしないで、 H_2/N_2 、 N_2 等の非酸化性雰囲気中で加熱溶融接合した場合、第2図(b)、(c)に示すように、ぬれ、溶融はんだの表面張力によるフィレット形成、球帯化およびセルフアライメントが不十分である。

上記の問題点を解決するために、第3図に示すような手段を採用した。第3図(a)は初期のろう材表面状態、第3図(b)はスパッタクリーニング後の表面状態、第3図(c)は大気中での再酸化状態、第3図(d)は加熱溶融した時の表面状態、第3図(e)は拍融接合後の表面状態を示している。第3図(b)に示すように、ろう材表面の酸化層および有機物汚染層を除去する。その後、大気中で作業をした後、非酸化性雰囲気中でノンフラックス接合を行うものである。スパッタクリーニング後、大気中を通過させても、ろう材表面に生成する再酸化層、再汚染層は、第3図(c)に示すように、クリーニング前の初期の状態と比較して非常に薄い。そこで、第3図(d)に示すように、非酸化性雰囲気中で加熱溶融した

上記従来技術は、非酸化雰囲気中で位置合わせ及び加熱を行っていたので、設備が複雑かつ大型になるという問題があった。また、非酸化雰囲気中での位置合わせは非常に困難であった。

本発明の目的は、ノンフラックスで接合を行うことにある。

本発明の他の目的は、作業性を良くするため、材料あるいは部材およびろう材を大気中で位置合わせ等の作業を行い、これをノンフラックス接合することにある。

〔課題を解決するための手段〕

上記目的を達成するために、被接合材およびろう材の表面の汚染層、酸化層を原子あるいはイオンでスパッタクリーニングで除去し、非酸化性雰囲気中で加熱溶融したものである。

上記他の目的を達成するために、大気中での保持時間とろう材の再酸化、再汚染との関係から、大気中で作業可能な時間を求めたものである。

第2図(a)に示すように、ろう材の表面には、厚い酸化層および有機物汚染層が存在する。その



際、ろう材が膨張して薄い酸化皮膜が破れ表面が再酸化しないので、新生な露出面が現れる。この状態で接合すると、メタライズ等の被接合材に新生面がぬれ初め、全体にスムーズにぬれ拡がり、第3図(e)に示すように、良好な接合が得られる。

〔作用〕

原子あるいはイオンで、被接合材およびろう材をスパッタクリーニングすることにより、表面の酸化層および汚染層を除去することができる。

また、非酸化性雰囲気中でろう材を加熱溶融させることにより、再酸化を防止して表面の清浄さを保ち、ろう材のぬれ性を良好な状態に保つことができる。

大気中で位置合わせ作業を行うことができるので、容易に作業及び簡単な設備で位置合わせ作業を行うことができる。

大気中で、ろう材が再酸化、再汚染しても、ノンフラックス接合可能な限界の経過時間を求めることにより、その時間内で大気中作業後、非酸化

・ 5 ・

・ 8 ・

性雰囲気中で接合を行うことにより、ノンフラックス接合を可能にしている。

〔実施例〕

以下、本発明の実施例を第4図、第5図により説明する。

第4図は、本発明の第1の実施例を示したものである。半導体集積回路1を、セラミック基板3の作成工程においてタングステンやモリブデンを焼付けその上にNi、Auを順次めっきを施して形成したメタライゼーションパッド8に、Pb5Snはんだ9を用いて接合したものである。第4図(a)に示すように、Pb5Snはんだ9、メタライゼーションパッド8ともに、Ar原子7によりスパッタクリーニングし、酸化層および有機物汚染層を除去する。次に、第4図(b)に示すように、大気中で30分以内で位置合わせした後、 H_2/N_2 ($H_2:N_2=1:3$) 炉中で加熱溶融し、接合を行い、ノンフラックスで第4図(c)に示すような良好な接合部を得ることができた。本実施例の全体像を第4図(d)に示している。同様

に、大気中で1時間、2時間、5時間、8時間暴露後、 H_2/N_2 炉中で加熱接合を行った結果、5時間までは良好な接合を示したが、8時間では接合はするが、形状が球帯形状からはずれることがわかった。この程度の時間が接合限界と推定される。

次に、本発明の第2の実施例を第5図に示す。AgNキャップ7をセラミック基板3に、Sn37Pb10を用いて接合する封止構造体を示したものである。第5図(a)に示すように、AgNキャップ11、セラミック基板3に供給されているSn37Pbはんだ10の表面をスパッタクリーニングし、酸化層、汚染層を除去する。次に、第5図(b)に示すように、大気中で30分以内で位置合わせした後、 H_2/N_2 炉中で加熱溶融し、ノンフラックス接合を行うことにより、第5図(c)に示すような良好な接合部を得ることができる。同様に、大気中暴露時間を変えて接合した結果、第4図の例と同じ傾向を示した。被接合材へのろう材の供給も同様にノンフラックスで行う。

7.

8.

同様にして、PbとSnとからなる他のろう材、SnとAg、AuとSn、AuとCuおよびAuとSiからなる他のろう材についてもノンフラックスで接合できる。

上記の結果のように、大きな熱容量をもつ被接合材のノンフラックス接合と接合時の位置合わせ作業を容易かつ簡単な設備で行うためには、大気中での作業と従来から使用されている非酸化性雰囲気炉とにより、加熱溶融できることが重要である。そこで、これを可能とするため、ろう材の許容酸化皮膜の観点から酸化特性を調べたのが、第6図である。その酸化に対する大気中暴露時間の限界は、大気中暴露時間と酸化膜厚との関係から定量的に求めることができ、第4、5図で示した結果とほぼ一致する約6時間以上である。また、Pb5Snの100℃と150℃の結果より温度上昇に伴い酸化膜厚の成長速度が大きくなるため、高温環境では大気中暴露時間を短くする必要がある。

スパッタクリーニング後の、この酸化膜厚で接合するには、さらに以下の特性を満足しなければ

ならなかった。各種のろう材に対して、接合とに必要な特性は、ぬれ性が良好なこと、ボイドが少ないこと、接合形状が溶融はんだの表面張力に従った形状になること、位置合わせずれを溶融接合時に修正するセルフアライメントが起こること、および信頼性(T_{∞} 、高温放置強度)が良好なことである。本発明を用いた接合(H_2/N_2 雰囲気)と従来法(スパッタクリーニング無、フラックス有無)を用いた接合について、これらの特性を比較したのが第1表である。

以下余白

9.

第 1 表

	ろう 材	ぬれ性 (ぬれ面積 100% 以上)	ボイド	接合 強度	セルフ アライメント 性	温度サイクル寿命 -55~+150℃ 0T=試験, 1000=回
本 発 明 (H_2/N_2 中)	1. Pb2Sn	○	△	○	○	○
	2. Pb5Sn	○	△	○	○	○
	3. Pb10Sn	○	△	○	○	○
	4. Sn37Pb	○	△	○	○	○
	5. Sn3.5Ag	○	△	○	○	○
	6. Au12Ge	○	△	○	○	—
従 来 法 (N_2 中)	1. Pb2Sn	○	多	○	○	△(2/20 不良発生)
	2. Pb5Sn	○	多	○	○	△(3/20 ")
	3. Sn37Pb	○	多	○	○	△(5/20 ")
	4. Sn3.5Ag	○	多	○	○	△(2/20 ")
	5. Pb5Sn	×	△	×	×	—
	6. Sn3.5Ag	×	△	×	×	—
	7. Au12Ge	×	△	△	△	—

本発明を用いた接合は、ぬれ性、接合形状およびセルフアライメント性において、従来法のフラックス有での接合と同程度の優れた特性を示している。

・ 11 ・

ある。これにより、益々増加する電子回路装置を組立てる際、容易な作業、簡単な設備により無公害で、信頼性の向上が図れる。

4 図面の簡単な説明

第1図は従来のフラックスを用いた接合の1例を示した断面図、第2図はろう材表面をスパッタクリーニングしないでノンフラックス接合を行った1例を示した断面図、第3図はろう材表面をスパッタクリーニング後、ノンフラックス接合を行った1例を示した断面図、第4図は本発明の第1の実施例の半導体集積回路とセラミック基板との接合を示した断面図、第5図は本発明の第2の実施例の封止構造体における接合を示した断面図、第6図は各種ろう材のスパッタクリーニング後の大気中暴露時間と酸化膜厚との関係を示した図である。

- 1…半導体集積回路、 2…はんだ、
3…セラミック基板、 4…フラックス、
5…ボイド、
6…酸化層及び有機物汚染層、

・ 13 ・

る。ボイドに関しては、発生が少なくノンフラックスの効果が見われている。また、温度サイクル寿命についても、従来法のフラックス有の場合よりもさらに優れた特性をもっている。これに対して、フラックスを用いない従来の方法では、いずれの特性も悪い。さらに、Ar、He、N₂雰囲気炉、フロンペーパー炉でも同様な傾向を示す。但し、この場合は、酸素濃度を約10ppm以下に抑えさる必要がある。

以上の特性の比較より、本発明を用いた接合は、従来法より優れており、すべての特性を満足する。

本発明は、他の電子回路部品、例えば、LSIパッケージ等のはんだ接続に適用し同様な結果が得られている。

【発明の効果】

本発明によれば、2つの異なる材料あるいは部材をろう材で接合する場合に、接合に必要な特性をすべて満足できるので、ノンフラックス接合で大気中での位置合わせ作業で、かつ熱容量の大きな被接合材も接合することができるという効果が

・ 12 ・

7…Ar原子、

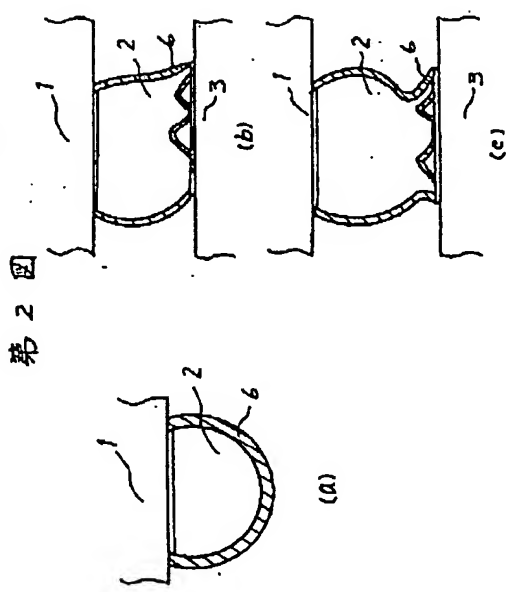
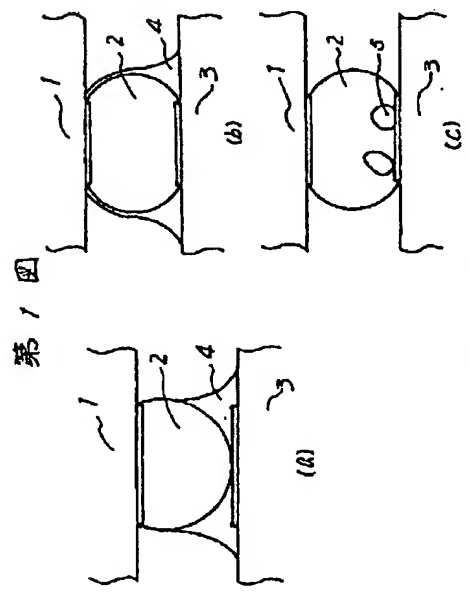
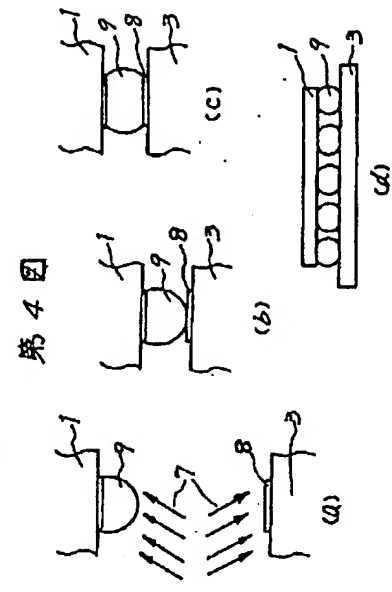
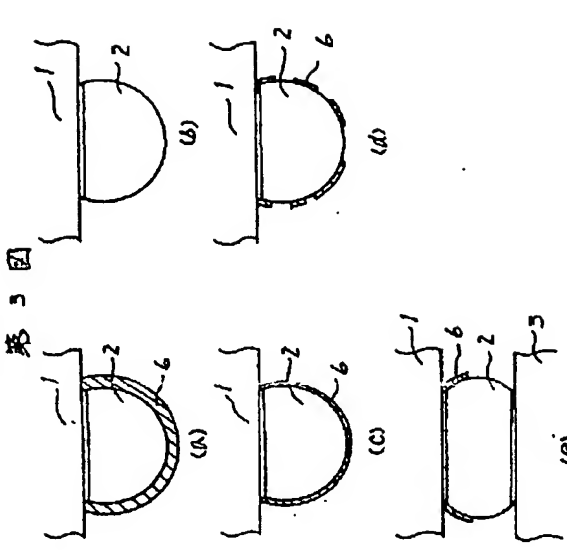
8…メタライゼーションパッドW/Hi/Au、

9…Pb5Snはんだ、10…Sn37Pbはんだ、

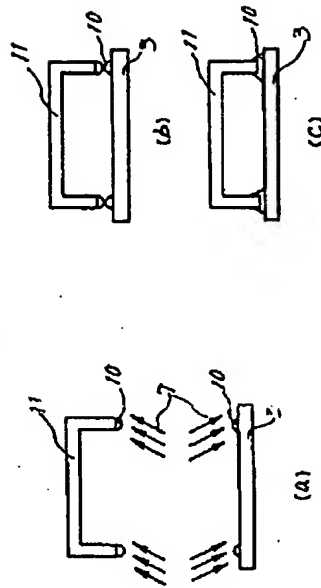
11…AgNキャップ。

代理人弁理士 小 川 勝

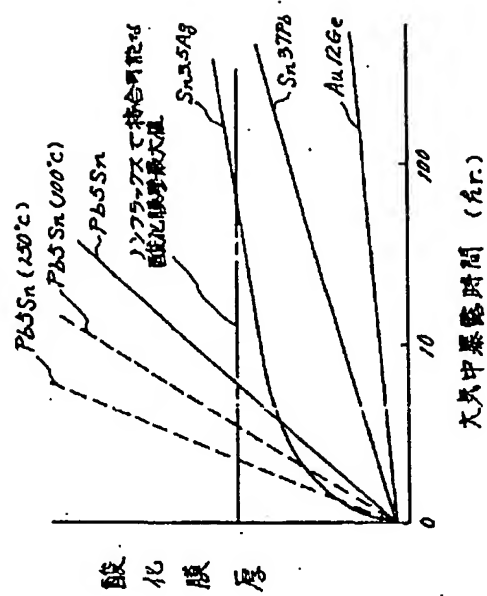




第 5 図



第 6 図



第 1 頁の続き

©Int. Cl.⁸

B 23 K 31/02

35/26

35/30

// B 23 K 101:36

識別記号

3 1 0 A

3 1 0 A

3 1 0 A

庁内整理番号

7217-4E

8719-4E

8719-4E

⑧発 明 者 白 井

貢

神奈川県秦野市堀山下 1 番地 株式会社日立製作所神奈川工場内

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】平成10年(1998)10月9日

【公開番号】特開平3-241755
 【公開日】平成3年(1991)10月28日
 【年通号数】公開特許公報3-2418
 【出願番号】特願平2-36033
 【国際特許分類第6版】

H01L 21/60 311
 B23K 1/00 330
 1/20
 31/02 310
 35/26 310
 35/30 310

// B23K 101:36

【F I】

H01L 21/60 311 S
 B23K 1/00 330 E
 1/20 H
 31/02 310 A
 35/26 310 A
 35/30 310 A

手続補正書 (自発)

補正 3 年 2 月 19 日

特許庁長官殿

事件の表示

平成2年特許願第86033号

補正をする者

特許出願人

（510）ホムズと日立製作所

代理人

〒100 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

株式会社日本実業株式会社 電話 3212-1111(大代表)

（6850）ホムズと小川勝男



補正により増加する請求項の数 4

補正の対象 明細書の特許請求の範囲の補、短明の詳
 細な説明の補及び図面の簡単な説明の補

補正の内容

1. 明細書の特許請求の範囲を前記のとおり補正する。
2. 明細書の次の箇所に変更された「ノンフラックス」と、それぞれ「フラックスレス」と訂正する。
 - (1) 明細書第3頁第7行乃至第8行、(2) 明細書第3頁第11行、
 - (3) 明細書第4頁第8行、(4) 明細書第4頁第9行、
 - (5) 明細書第5頁第16行、(6) 明細書第5頁第18行乃至第19行、
 - (7) 明細書第7頁第1行乃至第2行、(8) 明細書第7頁第18行、
 - (9) 明細書第8頁第18行、(10) 明細書第8頁第24行、
 - (11) 明細書第9頁第3行乃至第4行、(12) 明細書第9頁第6行、
 - (13) 明細書第12頁第1行乃至第2行、(14) 明細書第12頁第13行、
 - (15) 明細書第13頁第7行、(16) 明細書第13頁第9行、
3. 明細書第3頁第5行の「ボイド」を、「ボイド5」と訂正する。
4. 明細書第3頁第7行の「ノンフラックスを用いて」と、「フラックスレスにより」と訂正する。
5. 明細書の次の箇所に変更された「非酸化雰囲気」と、それぞれ「非酸化雰囲気」と訂正する。
 - (1) 明細書第3頁第16行、(2) 明細書第4頁第1行、
 - (3) 明細書第4頁第3行、
6. 明細書第4頁第12行乃至第15行の「上記目的を……したものである。」を、次のように訂正する。

「上記目的を達成するために、本発明は、部品と回路基板をフラックスレスではんだ実装する電子回路装置の製造方法において、部品または回路基板に接合されたはんだ実装の酸化膜を除去する工程と、次いで上記部品及び回路基板を大気中にて並置合わせをする工程と、仮接合をさせた部品及び回路基板のほんだを非酸化雰囲気内にて加熱溶融する工程を備え、部品及び回路基板を接合することを特徴とするものである。」
7. 明細書第4頁第24行及び第5頁第13行の「酸化膜および有機物汚染層」を、それぞれ「酸化膜および有機物汚染層6」と訂正する。
8. 明細書第5頁第12行の「図3図(b)」を、「図3図(a)から(b)」

と訂正する。

9. 明細書第9頁第6行の「ぬれ地の」を、「ぬれ地の」と訂正する。
10. 明細書第9頁第16行の「容易は」を、「容易な」と訂正する。
11. 明細書第9頁第6行の「キャップ7」を、「キャップ11」と訂正する。

以上

特許請求の範囲

1. 2つの異なる材料あるいは部材をろう材で接合する電子回路装置の製造方法において、接合部およびろう材の表面の汚染層、酸化層を、原子あるいはイオンでスパッタクリーニング除去後、大気中で乾燥合わせ作業し、非酸化を多量含有するろう材を乾燥加熱することにより、フラックスレスで接合したことを特徴とする電子回路装置の製造方法。
2. 上記ろう材がPbとSn、SnとAg、AuとSn、AuとCu、AuとSi、またはこれらの組合せからなることを特徴とする請求項1記載の電子回路装置の製造方法。
3. 上記接合部およびろう材の表面の汚染層、酸化層のスパッタクリーニング後の大気中滞留時間が、6時間以内であることを特徴とする請求項1記載の電子回路装置の製造方法。
4. 上記ろう材が、フッ素系樹脂であることを特徴とする請求項1記載の電子回路装置の製造方法。
5. 上記ろう材が、H₂、Ar、He等の不活性雰囲気であることを特徴とする請求項1記載の電子回路装置の製造方法。
6. 上記ろう材が、H₂/N₂、N₂等の還元雰囲気であることを特徴とする請求項1記載の電子回路装置の製造方法。
7. 部品と回路基板をフラックスレスで組み立てる電子回路装置の製造方法において、
部品または回路基板に接合されたはんだ表面の酸化層を除去する工程と、
次いで上記部品及び回路基板を大気中にて乾燥合わせする工程と、
乾燥合わせした部品及び回路基板のはんだを非酸化雰囲気内にて加熱処理する工程を備え、部品及び回路基板を接合することを特徴とする電子回路装置の製造方法。
8. 半導体素子回路と回路基板をフラックスレスではんだ接合する電子回路装置の製造方法において、
半導体素子回路に接合されたはんだ表面及び回路基板のパッドの表面の酸化層を除去する工程と、

次いで上記半導体素子回路に接合されたはんだ及び回路基板のパッドを大気中にて乾燥合わせする工程と、

乾燥合わせした半導体素子回路及び回路基板のパッドのはんだを非酸化雰囲気内にて加熱処理する工程を備え、半導体素子回路と回路基板を接合することを特徴とする電子回路装置の製造方法。

9. 回路基板をキャップで封止する電子回路装置封止用装置の製造方法において、

キャップ及び回路基板に接合されたはんだ表面の酸化層を除去する工程と、
次いで上記キャップに接合されたはんだ及び回路基板を大気中にて乾燥合わせする工程と、

乾燥合わせしたキャップ及び回路基板のはんだを非酸化雰囲気内にて加熱処理する工程を備え、キャップ及び回路基板を接合することを特徴とする電子回路装置封止用装置の製造方法。

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.